

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 1 区分
 【発行日】平成 18 年 4 月 20 日 (2006.4.20)

【公開番号】特開 2003-338368 (P2003-338368A)
 【公開日】平成 15 年 11 月 28 日 (2003.11.28)
 【出願番号】特願 2003-59146 (P2003-59146)
 【国際特許分類】

H 0 5 B 33/04 (2006.01)

H 0 5 B 33/10 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

【F I】

H 0 5 B 33/04

H 0 5 B 33/10

H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 3 月 3 日 (2006.3.3)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 3】

そして、ゲート絶縁膜 1 2 及び能動層 4 3 上の全面には、層間絶縁膜 1 5 を形成し、ドレイン信号線 5 2 と同層で駆動電源 5 0 と一体の駆動電源線 5 3 が配置される。更に全面に平坦化絶縁膜 1 7 が配置され、ソース 4 3 s とコンタクトした I T O (Indium T in Oxide) 等から成り画素毎に独立した第 1 の電極 6 1、即ち有機 E L 素子の陽極 6 1 が配置される。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 6 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 6 1】

更に全面に例えば有機樹脂から成り表面を平坦にする平坦化絶縁膜 1 7 を形成して、その平坦化絶縁膜 1 7 の第 2 の T F T のソース 4 3 s に対応した位置にコンタクトホールを形成する。このコンタクトホールを介してソース 4 3 s とコンタクトした I T O (Indium T in Oxide) 等から成る第 1 の電極、即ち陽極 6 1 をスパッタによって形成する。